```
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.
011076573
              **Image available**
WPI Acc No: 1997-054497/199706
Related WPI Acc No: 2002-332026
XRPX Acc No: N97-044684
  Manufacturing ink jet heat for computer printer - forming anti-etching
  mask for ink supply port on back of silicon substrate and removing
  silicon at port portion
Patent Assignee: CANON KK (CANO )
Inventor: OHKUMA N
Number of Countries: 025 Number of Patents: 016
Patent Family:
Patent No
                      Date
                              Applicat No
                                             Kind
                                                     Date
                                                              Week
               Kind
EP 750992
                   19970102 EP 96110504
                                                   19960628
                                                             199706
               A2
                                              Α
AU 9656269
                    19970109 AU 9656269
                                                   19960701
                                                             199710
               Α
                                              Α
                             JP 95165799
JP 9011479
                    19970114
                                              Α
                                                  19950630
                                                             199712
               Α
CA 2179869
                    19961231
                             CA 2179869
                                              Α
                                                  19960625
                                                             199718
               Α
EP 750992
               AЗ
                   19970813 EP 96110504
                                                  19960628
                                              Α
                                                             199745
KR 97000570
                             KR 9626059
                                                  19960629
                    19970121
                                              Α
                                                             199802
               Α
                    19981001 AU 9656269
AU 9878681
                                                  19960701
                                                             199851
               А
                                              Α
                              AU 9878681
                                              Α
                                                  19980803
                   19980101 MX 962526
                                                  19960628
MX 9602526
                                                             199952
               A1
                                              Α
US 6139761
                             US 96670581
                                                  19960626
                                                             200057
               Α
                    20001031
                                              Α
CN 1145305
                             CN 96110212
                                                  19960628
                                                             200104
               Α
                    19970319
                                              Α
                              KR 9626059
                                              Α
                                                  19960629
                                                             200111
KR 230028
               В1
                   19991115
CA 2179869
               С
                    20010213
                              CA 2179869
                                              Α
                                                   19960625
                                                             200112
AU 734775
                              AU 9656269
                                                   19960701
                                                             200147 N
               В
                    20010621
                                              Α
                              AU 9878681
                                                   19980803
                                              Α
                    20020319
                              SG 9610177
                                                   19960628
                                                             200234
SG 86983
               Α1
                                              Α
EP 750992
               В1
                    20020605
                              EP 96110504
                                              Α
                                                   19960628
                                                             200238
                              EP 2001128741
                                              Α
                                                   19960628
DE 69621520
               F.
                    20020711
                              DE 621520
                                              Α
                                                   19960628
                                                             200253
                              EP 96110504
                                                   19960628
                                              Α
Priority Applications (No Type Date): JP 95165799 A 19950630
Cited Patents: No-SR.Pub; EP 609860; US 4789425; US 4985710; US 5308442
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                          Main IPC
                                      Filing Notes
               A2 E 14 B41J-002/16
EP 750992
   Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
   NL PT SE
AU 9656269
                        B41J-002/16
JP 9011479
              Α
                      8 B41J-002/16
CA 2179869
               Α
                        B21D-053/00
EP 750992
               Α3
                        B41J-002/16
KR 97000570
               Α
                        B41J-002/01
AU 9878681
               Α
                        B41J-002/14
                                      Div ex application AU 9656269
MX 9602526
               Α1
                        B41F-031/08
US 6139761
              Α
                        H01L-021/306
CN 1145305
                        B41J-002/16
               Α
KR 230028
               B1
                        B41J-002/01
CA 2179869
                        B41J-002/16
               С
AU 734775
               В
                        B41J-002/14
                                      Div ex application AU 9656269
                                      Previous Publ. patent AU 9878681
SG 86983
                        B41J-002/16
              A1
EP 750992
              B1 E
                        B41J-002/16
                                      Related to application EP 2001128741
```

03-Jul-03

Related to patent EP 1184179

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU , NL PT SE

DE 69621520 E B41J-002/16 Based on patent EP 750992

Abstract (Basic): EP 750992 A

The method of manufacturing an ink jet head involves preparing a silicon substrate. An ink ejection pressure generation element and a silicon oxide film are formed on the surface of the substrate. An anti-etching mask which forms an ink supply port is produced on the back of the substrate. Silicon on the back of the substrate is removed at the port portion through anisotropic etching. An ink ejection portion is formed on a surface of the substrate. The silicon oxide film is removed from the surface of the substrate of the ink supply port

USE/ADVANTAGE - For side shooter type printing head. Improved image quality due to accurate ink positioning. Accurate film formation. Easy to manufacture.

Dwg.1/15

Title Terms: MANUFACTURE; INK; JET; HEAT; COMPUTER; PRINT; FORMING; ANTI; ETCH; MASK; INK; SUPPLY; PORT; BACK; SILICON; SUBSTRATE; REMOVE; SILICON; PORT; PORTION

Derwent Class: L03; P52; P74; P75; T04

International Patent Class (Main): B21D-053/00; B41F-031/08; B41J-002/01; B41J-002/14; B41J-002/16; H01L-021/306

International Patent Class (Additional): B41F-003/81

File Segment: CPI; EPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): L03-D04G Manual Codes (EPI/S-X): T04-G02; T04-L05

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-11479

(43)公開日 平成9年(1997)1月14日

(51) Int.Cl.⁴
B 4 1 J 2/16

融別記号 广内整理番号

FI B417 2/04 技術表示箇所

B41J 3/04

103H

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平7-165799

(22)出願日

平成7年(1995)6月30日

(71)出題人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 大熊 典夫

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ

ン株式会社内

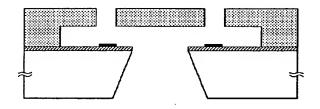
(74)代理人 弁理士 丸島 儀一

(54) 【発明の名称】 インクジェットヘッドの製造方法

(57)【要約】

【目的】 サイドシューター型インクジェットヘッドの 吐出口形成を平面基板上で行うことで、安価で精密なインクジェットヘッドを作成するインクジェットヘッドの 製造方法を提供する。

【構成】 シリコン基板上に酸化シリコン膜あるいは窒化シリコン膜を形成する工程と、前記シリコン基板の酸化シリコン膜あるいは窒化シリコン膜上にインク吐出圧発生素子を形成する工程と、前記シリコン基板の酸化シリコン膜あるいは窒化シリコン膜形成面の裏面にシリコン膜が成立の異方性エッチングによりインク供給口を形成する工程と、前記シリコン基板のマスク形成面から異方性エッチングを施しインク供給口となる部分のシリコンを除去する工程と、前記シリコン基板表面にインク吐出口部を形成する工程と、前記シリコン基板表面にインク吐出口部を形成する工程と、インク供給口部の酸化シリコン膜あるいは窒化シリコン膜を除去する工程と、を少なくとも含むことを特徴とするインクジェットへッドの製造方法。



させるための制御信号入力用電極 (図示せず) が接続さ れている。また、一般にはこれら吐出エネルギー発生素 子の耐用性の向上を目的として、保護層等の各種機能層 が設けられるが、もちろん本発明においてもこのような 機能層を設けることは一向にさしつかえない。

【0018】ここで、前記保護層に前述の異方性エッチ ングのストップ層である酸化シリコンもしくは窒化シリ コン層2を用いることもできる。(図1参照)

【0019】次に図2においてインク供給口を形成する ためのマスクとなる部材4を基板1のインク吐出圧発生 素子が形成されていない (裏面) 面に設ける。該部材4 は、シリコンの異方性エッチングのマスクとなるもので 酸化シリコン膜、窒化シリコン膜などが好適に用いられ る.ここで、部材4は必要に応じて基板の表面にも設置 することが可能で、前述の保護層などを兼用しても構わ ない。

【0020】ついで部材4のインク供給口となる部分を 通常のフォトレジストをマスクとして用い、CF。ガス を用いたドライエッチングにより除去する。ここで両面 マスクアライナー等の手段を用いることでインク供給口 の位置は表面のインク吐出圧発生素子に対して正確に決 定される。(図3)

【0021】次に、基板1を強アルカリ溶液に代表され るシリコン異方性エッチング液に浸漬し、インク供給口 5を形成する。(図4)ここで、基板表面は必要に応じ て保護される。また、シリコンの異方性エッチングは、 アルカリ性エッチング液に対する結晶方位の溶解度の差 を利用したもので、ほとんど溶解度を示さない<111 >面でエッチングは停止する。したがって、基板1の面 方位によってインク供給口の形状が異なる。面方位<1 00>を用いた場合には図4中の θ =54.7となり、 面方位<110>を用いた場合は $\theta=90$ °(基板表面 に対して垂直)となる。(図4は面方位<100>を用 いた場合を示す。)

【0022】酸化シリコンあるいは窒化シリコン層2は アルカリ性エッチング液に耐性を持つためエッチングは ここで停止する。(図5参照)したがってエッチングの 正確な終点検知は必要としない。

【0023】次に、基板1上にノズル部の形成工程に入 る。ここでは、前述の溶解可能な樹脂層を用いた製造方 法で説明する。ここで基板1はインク供給口上も酸化シ リコンあるいは窒化シリコン膜2で被われていて平面と なっておりスピンコートあるいはロールコート等の塗布 手段を用いることができることより・およそ50μm以 下の膜厚であれば、任意の膜厚で高精度に成膜できる。 ・ドライフィルム化できない材料(被覆性に乏しい材

料〉も使用できる。などの利点を有する。

【0024】このようにして、スピンコートあるいはロ ールコートで溶解可能な樹脂層を基板1上に成膜し、パ ターニングしインク流路6を形成する。(図6)

【0025】次に図7に示すように被覆樹脂層7を形成 する。該樹脂はインクジェットヘッドの構造材料となる ため、高い機械的強度、耐熱性、基板に対する密着性お よびインク液に対する耐性やインク液を変質せしめない 等の特性が要求される。

【0026】前記被覆樹脂層7は光または熱エネルギー の付与により重合、硬化し基板に対して強く密着するも のが好適に用いられる。

【0027】被覆樹脂層7が硬化された後、シリコン基 板1の裏面よりCF、などでプラズマドライエッチング することで、インク供給口5上の酸化シリコンあるいは 窒化シリコン膜2を除去し、インク供給口を貫通させ る。ここで、酸化シリコンあるいは窒化シリコン膜2の エッチング終点は正確に検知する必要はなく溶解可能な 樹脂層で形成されたインク流路パターン6中の任意の点 を持って終点とすれば良い。(図8参照)ここで、イン ク供給口5上の酸化シリコンあるいは窒化シリコン膜2 の除去は後述のインク吐出口形成後に行っても構わない が、インク流路パターン6を除去する前に行うことが好 ましい。

【0028】ついで被覆樹脂層7上にインク吐出口8を 形成する。(図9参照)インク吐出口の形成方法として は、被覆樹脂層7が感光性の場合は、フォトリソ技術に よってパターニングしても構わない。更に硬化した樹脂 層を加工する場合は、エキシマレーザーによる加工、酸 素プラズマによるエッチング等の手法が挙げられる。

【0029】ついで図10に示すように、インク流路バ ターンを形成する溶解可能な樹脂層6を溶出する。この ようにして形成したインク流路およびインク吐出口を形 成した基板に対して、インク供給のための部材およびイ ンク吐出圧発生素子を駆動するための電気的接合を行っ てインクジェットヘッドが形成できる。

【0030】更に、前記インクジェットヘッドの作成手 順では異方性エッチング→ノズル工程→異方性エッチン グストップ層の除去工程の場合で説明したが、ノズルエ 程→異方性エッチング工程→異方性エッチングストップ 層除去工程の順番で行ってももちろん構わない。すなわ ち、基板1の裏面にマスク部材4を形成し(図2もしく は図3の状態)、次いでノズル部の形成工程を行った後 で、異方性エッチング工程を行う手順である。ただしこ の場合には、多くのノズル形成部材が異方性エッチング 液に対して耐性を持たないためノズルが形成された基板 表面に異方性エッチング液が回り込まないように適宜保 護する必要がある。

【0031】 (実施例1) 本実施例では、前述の図1~ 図10に示す手順にしたがってインクジェットヘッドを 作成した。まず、結晶面方位<100>のシリコンウエ ハー(厚さ500μm)に熱酸化により酸化シリコン膜 を両面に形成した。(厚さ2.75μm)次いで、吐出 エネルギー発生素子として電気熱変換素子およびこれら

素子を動作させるための制御信号入力用電極を酸化シリコン膜上に形成した。(以後、電気熱変換素子が形成された面を表面と記す。)

【0032】ここで、シリコンウエハー裏面には、熱酸化により酸化シリコン膜が形成されているため新たにシリコンの異方性エッチングのためのマスク部材を設ける必要はない。裏面の酸化シリコン膜は、インク供給口に相当する部分のみ CF_4 ガスによるプラズマエッチングにより除去される。(図3)

【0033】次いで前記シリコンウエハーを30%水酸化カリウム水溶液に110℃ 2時間浸漬しシリコンの異方性エッチングを行った。ここでウエハー表面には、ゴム系のレジストを保護膜として設置し、更に水酸化カリウム水溶液が接触しない構成とした。異方性エッチングはシリコンウエハーの表面の酸化シリコン膜で停止するため、エッチング時間、温度の正確な管理は必要とせずインク供給口に相当するシリコンが完全に除去される条件で行えば良い。(図5)

【0034】異方性エッチングされたシリコンウエハーは、純水洗浄、表面のご無形レジストの除去を行い、ノ ズル部の形成工程に入る。

【0035】まず、溶解可能な樹脂層としてPMER A-900(東京応化工業(株)社製)をスピンコートで形成し、キャノン製マスクアライナーMPA-600にてパターニング、現像することでインク流路の型を形成した。(図6)前記PMER A-900はノボラック型レジストであり、高い解像性、安定したパターニング特性を有するものであるが、被膜性に乏しくドライフィルムかは困難である。ここで本発明においては、シリコンウエハー表面は平面に保たれているためノボラック系のレジストもスピンコートで正確な膜厚で形成することができる。

【0036】次ぎに、ノズルおよびインク吐出口を形成する被覆樹脂層を前記インク流路の型となる溶解可能な樹脂層上にスピンコートで形成した。(図7)被覆樹脂層は、インクジェットへッドの構造材料となるため高い機械的強度、基板に対する密着性、耐インク性等が要求されエポキシ樹脂の熱あるいは光反応によるカチオン重合硬化物が最適に用いられる。本実施例においては、エポキシ樹脂としてEHPE-3150(ダイセル化学工業(株)社製) 脂環式エポキシ樹脂)、熱硬化性のカチオン重合触媒として4、4'ージーセーブチルジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート/銅トリフラートからなる混合触媒を用いた。

【0037】次にインク供給口を貫通させるためにインク供給口上の酸化シリコン膜を除去する。酸化シリコン膜はシリコンウエハーの裏面よりCF4ガスを用いたプラズマエッチングにより除去できる。ここでインク供給

口上には後工程で除去する溶解可能な樹脂層が充填されているためプラズマエッチングは、この溶解可能な樹脂中の任意の点で終了させれば良く、被覆樹脂層になんらプラズマエッチングに影響を与えることがない。(図8)また、酸化シリコン膜はふっ酸に浸漬することでウエットエッチングも可能である。

【0038】次に被覆樹脂層上にインク吐出口を形成する。本実施例においては酸素プラズマエッチングにより 吐出口を形成する例を示す。

【0039】インク供給口上の酸化シリコン膜を除去したシリコンウエハーの被覆樹脂層上にシリコン含有ポジ型レジストFH-SP(富士ハント(株)社製)9を塗布し、インク供給口と信号入力のための電気的接合部を行う部分(図示せず)をパターニングする。(図11)次に、酸素プラズマエッチングにより吐出口部および電気的接合部(図示せず)をエッチングする、前記レジストFH-SPは耐酸素プラズマ膜として作用し、吐出口部のみが溶解可能な樹脂層中の任意の点で終了させれば良く、ヒーター面になんらダメージを与えることはない。(図12)

【0040】本実施例においては、酸素プラズマエッチングにより吐出口を形成したが、エキシマレーザーをマスクを介して照射することでアブレーションにより吐出口を形成することも可能である。

【0041】次に、溶解可能な樹脂層およびFH-SP 膜を洗い出す。(図10)

【0042】最後にインク供給部材、信号入力のための電気的接続を行ってインクジェットヘッドが完成する。 【0043】この様にして作成したインクジェットヘッドを記録装置に装着し、純水/ジエチレングリコール/イソロピルアルコール/酢酸リチウム/黒色染料フードブラック2=79.4/15/3/0.1/2.5からなるインクを用いて記録を行ったところ安定な印字が可能であり、得られた印字物は高品位なものであった。

【0044】また、前述のごとく、本実施例のインクジェット記録へッドは、ヒーター前方のすべてのインクを吐出させる吐出方式のため、ノズル構造がばらつきなく正確に作成できれば(特にノズル高さ=溶解可能な樹脂層+被覆樹脂層)ノズル間の吐出量のばらつきは極めて小さくなるはずである。そこで本実施例で作成したインクジェットへッドを用いて吐出量のばらつきを測定した。吐出量のばらつきは被記録媒体(コート紙)上に1ノズルずつ吐出、特定パターンで印字を行った場合の光学密度(O.D)の平均値と標準偏差(サンプル数10)を求め、その結果を下記表1に示す。

[0045]

【表1】

弘 文 · 故 八 本

表 1

	O.D平均值	標準偏差σ
パターン1	0.72	0.01
パターン2	1.45	0.01

【0046】表1から理解される様に本実施例で作成したインクジェットヘッドは、ノズル間の吐出量ばらつきがほとんどなく、高品位な画像を形成できる。

【0047】(実施例2)本実施例では、ノズル工程→ 異方性エッチング→異方性エッチングストップ層除去工 程の手順でインクジェットヘッドを作成した。

【0048】まず、結晶面方位<100>のシリコンウエハー1(厚さ500μm)表面に吐出エネルギー発生素子として電気熱変換素子3およびこれら素子を動作させるための駆動回路を作成した。ついて異方性エッチングのストップ層として窒化シリコン膜2をシリコンウエハー表面に形成した(図1参照)なお、前記窒化シリコン膜2は、電気熱変換素子の保護膜としても機能する。継いで、ウエハー裏面に異方性エッチングのマスク部材4として窒化シリコン膜を形成した。(図2)

【0049】次に、本実施例では、ノズル部の形成工程に入る。実施例1と同様に溶解可能な樹脂層としてPMER A-900を用いインク流路型を形成し、更に被覆樹脂層を形成した。被覆樹脂層は前記実施例1と同様の組成物を用いた。ここで前記組成物は、4、4'ージーセーブチルジフェニルヨードニウムへキサフルオロアンチモネート/銅トリフラートからなる混合触媒は感光性を有しているためフォトリソグラフィーによりインク吐出口を形成した。すなわち、被覆樹脂層形成後にマスク12を介してキヤノン製マスクアライナーPLA520(コールドミラー250)で露光し(図3)、現像することでインク吐出口を形成した(図4)。

【0050】次いで、前記ウエハーを22TMAH (テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド) 水溶液に80℃ 15時間浸漬しシリコンの異方性エッチングを行った

【0051】この際、ノズル部が形成されたウエハー表

面には、TMAH水溶液が接触しない構成とした。異方性エッチング終了後は、実施例1と同様にしてインク供給口上の窒化シリコン膜および溶解可能な樹脂層を除去することでインクジェットヘッドが完成する。

【0052】最後に実施例1と同様にインク供給部材、 信号入力のための電気的接続を行ったところ、良好な印 字が可能であった。

【0053】(実施例3)本実施例は、特開昭62-264957号明細書記載の方法に本発明を利用した場合を示す。

【0054】シリコンの異方性エッチングによるインク 供給口の形成までは実施例1と同様に作成する。(図 5)

【0055】次いで、ノズルを構成する樹脂層10をスピンコートで形成、光照射によりパターニング、現像を行う。(図13)

【0056】ここで樹脂層10は、シリコンウエハー表面が平面に保たれているため、スピンコートで成膜可能なために以下の利点を有する。

- ・任意の膜厚に構成度に成膜でき(ドライフィルムでは、困難なおよそ15μm以下も可能)、設計自由度が 広がる。
- ・ドライフィルムを用いた場合のインク供給口への垂れ 込みが起こらないためにノズル部にインク供給口を近ず けることが可能となる。(インクジェットヘッドの動作 周波数の向上)
- ・ドライフィルムか困難な材料(被覆製に乏しい材料) も使用できる。

【0057】本実施例においては、ノズル構成材料として下記表2に示す組成物を用いた。

【0058】

【表2】

表 2

		重量部	
エポキシ樹脂	オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂 エピコート 180H65 (油化シェルエポキシ社製)	80部	
	プロビレングリコール 変性 ビスフェノールA 型エポキシ樹脂	15部	
シランカップリング材	A - 187 (日本ユニカー社製)	3部	
光カチオン重合開始剤	SP-170 (旭電化工業社製)	2部	

【0059】表2に示す組成物は、耐インク性に優れる ものの被膜性の乏しく、スピンコートによって初めてシ リコンウエハー上に膜厚をコントロールしつつ成膜可能 となる。

【0060】次いで実施例1と同様にしてインク供給口上の酸化シリコンを除去する。(図14)次いで、ニッケルの電鋳により作成したインク吐出口8を有する部材11を位置合わせして、ノズル構成材料10上に熱圧着することでインクジェットへッドが作成できる(図15)。最後に実施例1と同様にインク供給部材、信号入力のための電気的接続を行ってインクジェットへッドとし、印字評価を行ったところ、良好な印字が可能であった。

[0061]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によればインク吐出口の形成を平面基板上で行うことが可能なため成膜精度が高く、インク吐出口部を形成する部材の選択範囲を広げることができるという効果を有する。また、インクジェットへッドのインク吐出特性に影響を及ぼす最も重要な因子のひとつである、吐出エネルギー発生素子とオリフィス間の距離及び該素子とオリフィス中心との位置精度の設定が極めて容易に実現できるとともに、インク供給口形成の位置精度が高くインク吐出圧発生素子との距離を短くできるため、動作周波数の高いインクジェットへッドが容易に作成することができるという効果をも有するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】シリコンの異方性エッチングによるインク供給 口の形成工程を示す模式図

【図2】シリコンの異方性エッチングによるインク供給 口の形成工程を示す模式図

【図3】シリコンの異方性エッチングによるインク供給 口の形成工程を示す模式図 【図4】シリコンの異方性エッチングによるインク供給口の形成工程を示す模式図

【図5】シリコンの異方性エッチングによるインク供給 口の形成工程を示す模式図

【図6】インク吐出口の形成工程を示す模式図

【図7】インク吐出口の形成工程を示す模式図

【図8】インク吐出口の形成工程を示す模式図

【図9】インク吐出口の形成工程を示す模式図

【図10】インク吐出口の形成工程を示す模式図

【図11】インク吐出口を酸素プラズマエッチングにより形成する工程の模式図

【図12】インク吐出口を酸素プラズマエッチングにより形成する工程の模式図

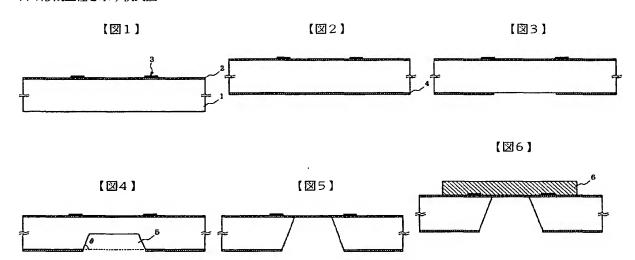
【図13】インク吐出口を有する部材を張り合せてイン ク吐出口を形成する工程の模式図

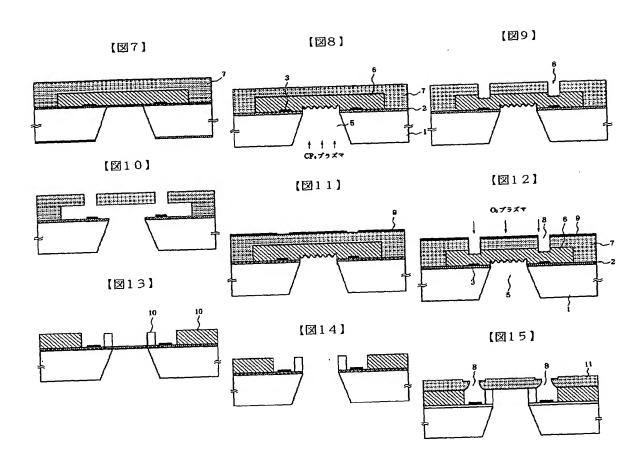
【図14】インク吐出口を有する部材を張り合せてイン ク吐出口を形成する工程の模式図

【図15】インク吐出口を有する部材を張り合せてイン ク吐出口を形成する工程の模式図

【符号の説明】

- 1 シリコン基板
- 2 酸化シリコンあるいは窒化シリコン膜
- 3 インク吐出圧発生素子
- 4 シリコンの異方性エッチングのマスクとなる部材
- 5 インク供給口
- 6 溶解可能な樹脂層で形成されたインク流路パターン
- 7 被覆樹脂層
- 8 インク吐出口
- 9 シリコン含有ポジ型レジスト
- 10 ノズル構成材料
- 11 インク吐出口を有する部材
- 12 マスク





.